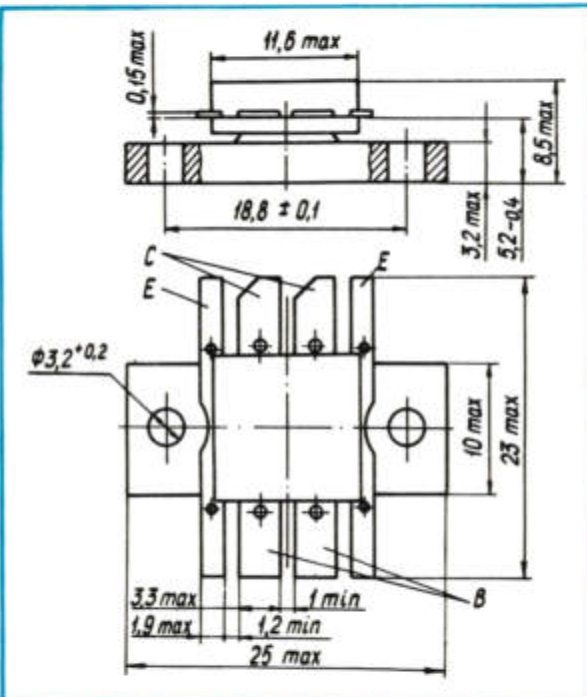


БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ СВЧ
HIGH POWER MICROWAVE



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п генераторные транзисторные сборки КТ985АС предназначены для построения двухтактных широкополосных усилителей мощности аппаратуры широкого применения.

Оформление - в металло-керамическом корпусе.

Диапазон допустимых рабочих температур от -40 до $+85^{\circ}\text{C}$.

GENERAL DESCRIPTION

The KT985AC Silicon planar-epitaxial generating transistor assemblies are designed for use in wide-band push-pull power amplifiers of equipment in a wide range of applications.

The assemblies are encapsulated in metal-ceramic cases.

Allowable operating temperatures:
-40 to +85°C.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BASIC TECHNICAL CHARACTERISTICS

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
MAXIMUM VALUES OF ALLOWABLE OPERATING CONDITIONS

$U_{CE \text{ max}}$ ($R_{BE} = 10 \Omega$)	50 V
$U_{BE \text{ max}}$	4 V
$U_S \text{ max}$	28 V
$I_C \text{ max}$	17 A
$P_C \text{ max}$	105 W
$P_C (AV) \text{ max}$	185 W
$t_j \text{ max}$	+160°C
$t_{\text{case max}}$	+85°C

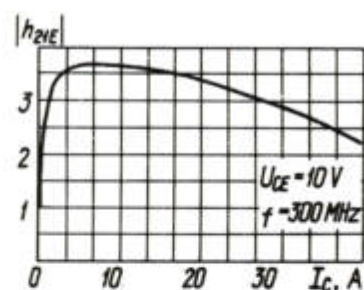
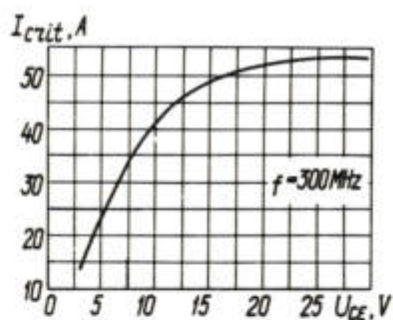
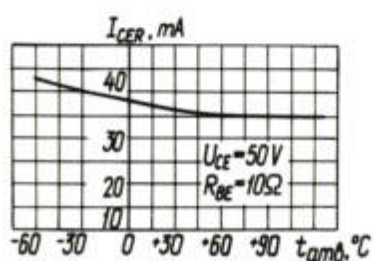
При $t_{\text{case}} > 40^\circ\text{C} \Rightarrow P_{C \text{ max}} = \frac{160 - t_{\text{case}}}{R_{\text{thic}} = 1,05^\circ\text{C/W}}$

(AV) - среднее значение ~ - динамический режим
average value dynamic operation

KT985AC

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	Значения Values	Режимы измерений Measuring conditions			
		$U_{CB}; U_{CE}^{\times}; U_{EB}^{\times\times}$ V	$I_C; I_E^{\times}$ A	f, MHz	R_{BE}, Ω
I_{CER}, mA	≤ 120	$50^{\times}$			10
I_{EBO}, mA	≤ 60	$4^{\times\times}$			
$ h_{21e} $	2,2 - 6,4	$10^{\times}$	4	300	
G_p	$\geq 3,5$	$28^{\times}$		400	
$\eta_C, \%$	≥ 50	$28^{\times}$		400	
C_C, pF	≤ 270	28		30	
τ_C, ns	10 - 21	10	$0,5^{\times}$	5	



KT985AC

